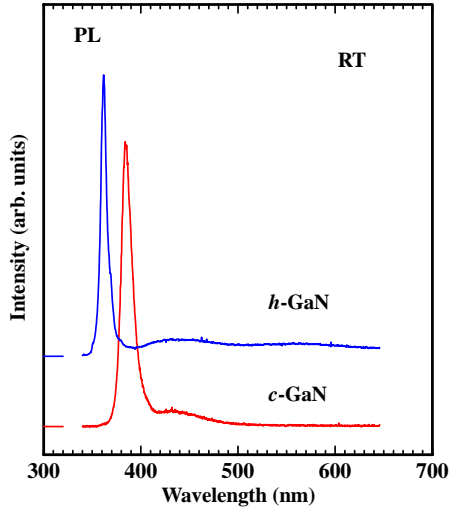
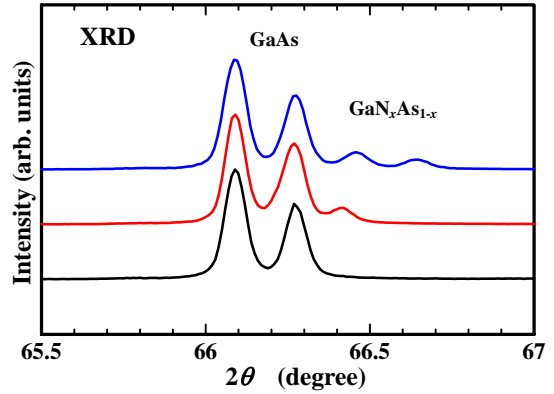


ECRラジカルセル (型式:RC-1400AE)

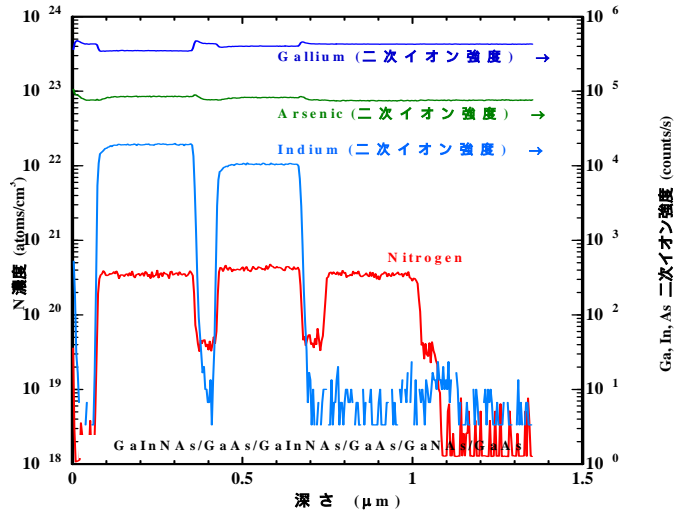
データ



ECRプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長(MBE)法により作製したh-GaNおよびc-GaN薄膜の室温でのPLスペクトル。マイクロ波供給電力: 60W, 窒素流量: 1.0 sccm。



ECRプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長(MBE)法により作製したGaNAs膜のX線回折プロファイル。マイクロ波供給電力: 5W, 窒素流量: 0.2 sccm。



ECRプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長(MBE)法により作製したGaInNAsおよびGaNAs膜のN濃度深さプロファイル。

データは大阪大学産業科学研究所 朝日研究室殿 ご提供

株式会社エピクエスト EpiQuest, Inc.

〒601-8142 京都市南区上鳥羽中河原 5 1

TEL 075-693-3356 FAX 075-693-3357

E-mail info@epiquest.co.jp URL <http://www.epiquest.co.jp>